

K - Si

1884

3090

Truchot

Compt. rend. 98, 1330 (1884)

Li_2SiO_6 , Na_2SiF_6 , K_2SiF_6
($\text{kp}, \text{p-p}, \Delta\text{Hf}^\circ$)

W, M

2085

1926

Hantke

1. An. ew. Chem. 39, 1065 (1926)

Na₂SiF₆; kp; ΔH_f⁰;

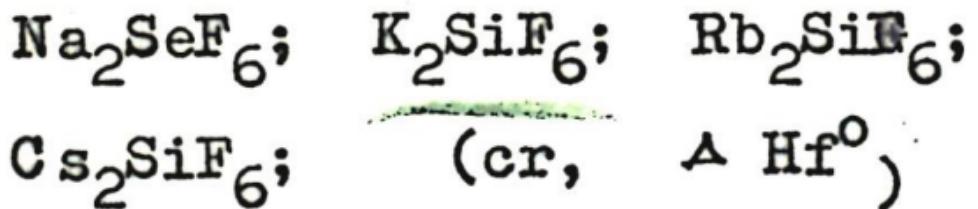
K₂SiF₆ kp; ΔH_f⁰;

at Circ. 500

M W

2027

1945



Caillot

1. Ann.chim.20, 367, 1945

M

Circ. 500

1412

1944

Naq (K_2SiF_6)

Рысс И.Г.

Ж.Физ.химии 1947, 21, 197-200

Растворимость ...

W

С.А., 1947, 6112б

K₂SiC₆. H. Martensky 11953

O wederh. Tite MgSiO_4
u MgSiO_4 u - Na_1K
Z. Anorg. Chem. 275, 257

J. Tifl.

KSi

Si - Силиций

RbSi

CsSi

KGe

RbGe

CsGe

+5

x. 1962. 22

11951

22Б162. Взаимодействие щелочных металлов с полуметаллами. X. Кристаллические структуры KSi, RbSi, CsSi, KGe, RbGe и CsGe. Bußmann E. Das Verhalten der Alkalimetalle zu Halbmetallen. X. Die Kristallstrukturen von KSi, RbSi, CsSi, KGe, RbGe und CsGe. «Z. anorgan. und allgem. Chem.», 1961, 313, № 1-2, 90—106 (нем.; рез. англ.).—Рентгенографически (методы Вейссенберга и порошка, λ Cu) определены кристаллические структуры KSi, RbSi, CsSi, KGe, RbGe, CsGe. Все соединения относятся к ф. гр. $P\bar{4}3n$, параметры решетки составляют соответственно: 12,62; 13,04; 13,50; 12,78; 13,19; 13,67 Å. Координаты атомов определены по проекциям Паттерсона и Фурье и сравнением F (выч.) и F (эксп.) для трехмерных данных (по порошкограммам). Приведены расстояния между атомами во всех структурах. Атомы Si и Ge в этих соединениях образуют 8 изолированных тетраэдров Si_4 и Ge_4 . Около этих тетраэдров расположены 16 атомов щел. металла. Каждый атом щел. металла окружен тетраэдром из 4 групп Si_4 и Ge_4 . Приведены значения J (эксп.) и J (выч.) линий рентгенограмм порошка. Сообщение IX см. РЖХим, 1962, 19B18. Л. Миркин

X-5179

1963

K₂SiF₆

(K_p, термодин. свой)

Байдурев В. Г.

Тр. Ии-та Химии АН СССР,
Уральский филиал, 1963, № 7, 27-31

ЕСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

М

СА, 1964, 61, N 5, 507-70

1967

K₈Si₄₆

10 Б419. K_8Si_{46} — силицид с клатратной структурой.
 Gallmeier J., Schäfer Herbert, Weiss Armin. K_8Si_{46} , ein Silicid mit Käfigstruktur. «Z. Naturforsch.», 1967, 22 b, № 10, 1080 (нем.)

Проведено полное рентгенографич. исследование (методы порошка и монокристалла, 700 рефлексов) фазы K_8Si_{46} ($KSi_{5,75}$). Кристаллы, обладающие металлич. блеском и устойчивые при нормальных атмосферных условиях, получены путем обработки элементарного Si парами K (800°). Параметры кубич. решетки a 10,30 Å, ф. гр. $Pm\bar{3}n$, ρ (эксп.) 2,39, ρ (выч.) 2,439. Ячейка содержит 8 атомов K и 46 Si. За основу модели принято на основе клатрата гидрита газов $8X \cdot 46H_2O$, где Si занимает место молекул H_2O , а пустоты между ними заняты

Х. 1968. 10

атомами К. Структура уточнена так, что для 0, 1, 2, 3, 4 и 5 слоевых линий значения $R(hkl)$, соответственно, 0,097; 0,119; 0,122; 0,104; 0,133 и 0,094. Положение атомов: $\text{Si}_{(1)}$ в 6(c) $1/4$; 0; $1/2$, $\text{Si}_{(2)}$ в 16(i) xxx с $x=0,185$, $\text{Si}_{(3)}$ в 24 (k) Oyz с $y=0,306$, $z=0,118$, $\text{K}_{(1)}$ в 2(a) 000, $\text{K}_{(2)}$ в 6(d) $1/4$; $1/2$; 0. Каждый атом Si в структуре окружен по тетраэдру 4 соседними Si. Две независимые группы (каждая из 20 атомов Si) образуют 2 пентагональных додекаэдра, расположенных по узлам объемноцент. кубич. решетки, но повернутых друг относительно друга на 90° . Между этими группами образуются 14-гранники с 2 шестиугольными и 12 пятиугольными гранями. В центрах додекаэдров и 14-гранников располагаются атомы K. Межатомные расстояния Si—Si 2,32—2,42 и K—Si 3,30—3,64 Å.

А. А. Воронков

A-1063

1964

K₆Si₄b; NaGe₄, " gp.
(kp. crp-pq)

Hagenmuller P., Naslain R., Poucharat,
Cros C.

Alkali Metals, London, Chem. Soc.,
1964, 207-221



M

ecf6 . q.k

K_2TiF_6 , K_2TiO_3 , K_2SiF_6 , K_2SiO_3 ($\alpha Zf, \rho$) 1962
Шенкелан Ф.Н., Ромашов А.А. № 6394

Тр. Им-та им. Фрунзеев фар. АУ СССР
1967, Вып 14, 103-106

Первый изоморфический ряд по составу
богатых в кислороде $KF - TiO_2 - SiO_2$.

РНК, 1968.

175331

если Q.K
M, 5 ♂

X 3972

1968

Na_2SiF_6 (K_{form}), NaCl , KCl , K_2SiF_6
(K_p).

Денишарский Ю. К., Чернова Р. В.,
Тонов А. Т.

Укр. хим. Ж., 1968, 34(9), 880-889.

СОЛ, 1969, 70, № 6, 23663 с. ectb р.к. ст

$\text{Na}_3\text{Bi}_2(\text{PO}_4)_3$, $\text{K}_3\text{Bi}_2(\text{PO}_4)_3$, 60 1969

$\text{Na Bi}_2[(\text{PO}_4)^{3-} + \text{SO}_4^{2-}]^{1/3-}$, $\text{K}_3\text{Bi}_2[(\text{PO}_4)^{3-} + \text{SO}_4^{2-}]^{1/3-} (T_m)$

Берудь С.И., Солоузы С.В. X4335

СН. неорганический, 1969, 14, N11, 3137-3139

Взаимодействие оксидов фосфатов с
ионами фосфатами металлов первой
группы.

РНХим, 1970

651015

○

5 (q)

1969

ВФ 4234-Х

K₂SiF₆P, Табл.

24 Б998. Исследование термической диссоциации систем, содержащих кремнефторид калия. Делмарський Ю. К., Голов О. Г., Чернов Р. В. Дослідження термічної дисоціації систем, що містять кремнефторид калію. «Укр. хім. ж.», 1969, 35, № 6, 563—568 (укр.); «Укр. хим. ж.», 1969, 35, № 6, 563—568 (русс.)

Статическим методом Юнга определено давление диссоциации нек-рых разрезов систем: $\text{NaCl}-\text{K}_2\text{SiF}_6-\text{KF}$; $\text{KCl}-\text{K}_2\text{SiF}_6-\text{KF}$; $\text{NaCl}+\text{KCl}$ (1 : 1) — $\text{K}_2\text{SiF}_6-\text{KF}$. Показано, что давление диссоциации K_2SiF_6 в присутствии растворителей — KF, KCl и NaCl и их эквимолярной смеси — ниже по сравнению с давлением диссоциации чистого K_2SiF_6 . Установлено, что величины давления диссоциации в системах $\text{K}_2\text{SiF}_6+\text{KF}-\text{NaCl}$; K_2SiF_6+

Х·1969.24

+ KF—KCl; $K_2SiF_6 + KF - NaCl + KCl$ (1 : 1) возрастают по сравнению с давлением диссоциации $K_2SiF_6 + KF$ по мере увеличения содержания MCl (M—K, Na) до максимума, а затем снижаются до давления паров MCl. По мере увеличения размера катиона щел. металла в системе $K_2SiF_6 + KF - MCl$ давление диссоциации расплавов падает. Определена т-ра разложения чистого K_2SiF_6 и т-ра плавления расплава, получающегося при плавлении $K_2SiF_6 (K_2SiF_6 + KF)$.

Резюме

A-1437

1969

Li, Na, K; Ba; NH₄ - крайне фториды,
трибориумоксиды, гексафтоританаты,
гептрафторомибаты, гептрафторогородаты
(о NH₄)

Раков Э.К.; Брагинчко В.Д., Марине-
на Л.К., Судариков Б.Н.,
Тр. Моск хим.-технол ин-та им. Д.И. Мен-
делеева, 1969, том. 62, 32-34. М

(K-Si)

Такахаси К.,
Мосио Т.

1970

SH;
экспоне
связи

J. Ceram. Soc. Jap.,
1970, 78, N902, 329.



(Cu. Zn-Si) I

1070

 $(CH_3)_3SiOK$ Крист.
структура

18 Б411. Рентгенографическое и масс-спектрометрическое исследование тритиатов щелочных металлов. Weiss Erwin, Hoffmann Klaus, Grützmacher Hans-Friedrich. Röntgenographische und massenspektrometrische Untersuchung der Alkalitrimesylsilanolate. «Chem. Ber.», 1970, 103, № 4, 1190—1197 (нем.; рез. англ.)

Рентгенографически исследованы (метод порошка, $\lambda Cu-K\alpha$) соединения $(CH_3)_3SiOM$, где M=K (I), Rb (II), Cs (III). Параметры кубич. решетки: a 8,844 Å (I); a 9,019 Å (II); a 9,295 Å (III); ф. гр. I—III $P\bar{4}3m$. I—III кристаллизуются в виде тетрамеров, аналогичных $[(CH_3)_3COM]_4$. Межатомные расстояния: K—O 2,61; Si—O 1,60; Si—CH₃ 1,81; CH₃—CH₃ 3,87 (I) и Rb—O

+2

X. 1970. 18



2,74; Si—O 1,61; Si—CH₃ 1,83; CH₃—CH₃ 3,92 (II). Углы связей: KOK 92°, OKO 88°, KOSi 123°, OSiCH₃ 110°, CH₃SiCH₃ 109° (I), RbORb 93°, ORbO 87°, RbOSi 123° OSiCH₃ 109° CH₃SiCH₃ 110° (II). Масс-спектры (MC) получены при т-ре испарения I (70—80°), II и III (80—100°). На основание MC сделан вывод, что в отличие от M=Li и Na в газовой фазе структуры I и III не гексамерны, а тетрамерны.

Б. А. Валовой

БСР 9031-X

1975

K_3SiF_7

15 Б986. Система NaF—KF—SiF₄. Мошненко В. М., Делимарский Ю. К., Чернов Р. В. «Ж. неорг. химии», 1975, 20, № 4, 1061—1063

(T_m)

Визуально-политермическим и ДТА методами анализов изучены системы KF—K₂SiF₆ и часть тройной системы NaF—KF—SiF₄. В системе KF—K₂SiF₆ имеется одно конгруэнтно плавящееся соединение K₃SiF₇, и две разграничитывающие эвтектики. Поле диаграммы плавкости тройной системы NaF—KF—SiF₄ разграничено кристаллизацией пяти солей: NaF, KF, K₂SiF₆, Na₂SiF₆ и K₃SiF₇, которые сходятся в двух тройных эвтектических точках.

Резюме

21.1975 N 15



4 Б341. Кристаллическая структура гексакалий гексателлур дисиликата $K_6[Si_2Te_6]$. Dittmar Günther. Die Kristallstruktur des Hexakaliumhexatellurodisilicats, $K_6[Si_2Te_6]$. «Acta crystallogr.», 1978, B34, № 8, 2390—2393 (нем.; рез. англ.)

(Tet) ?

Рентгенографически определена структура (методы Вейсснберга, пресессий и дифрактометра; λ Си и Мо, 1305 cm^{-1} линий, прямой метод определения знаков структурных амплитуд, МНК, анизотропное приближение, $R=0,061$) кристаллов $K_6Si_2Te_6$, синтезированных взаимодействием элементов в вакууме при $T=630^\circ$. Параметры монокл. решетки: $a=9,652$, $b=13,621$, $c=8,902 \text{ \AA}$, ρ (изм.) 3,36, ρ (выч.) 3,37, $Z=2$, ф. гр. $C2/m$. Особенностью структуры является тот факт, что атомы Si не находятся в обычном тетраэдрич. окружении из атомов Te, а образуют группировки Si_2Te_6 , в к-рых каждый из атомов Si характеризуется почти правильным тетра-

1979, N4

эдрич. окружением из трех атомов Te и одного атома Si (Si—Te 2,504, 2,523 Å, Si—Si 2,40). Идеальная симметрия этих группировок $32/m$ понижена до $2/m$. Отмечается, что соединение является первым примером структуры с подобными необычными структурными единицами. Между собой группировки Si_2Te_6 связаны атомами K, находящимися в 2 типах координации: октаэдрич. (K—Te 3454—3,814) и тригонально-призматич. (K—Te 3,453—3,698).

С. В. Соболева

K₂SiF₆

1981

5 Б949. Исследование состава продуктов пирогидролиза фторосиликата калия. Тесленко В. В., Раков Э. Г., Богатов К. Б., Харитонов В. П., Демидов В. П. «Изв. вузов. Химия и хим. технол.», 1981, 24, № 10, 1191—1195

В диапазоне т-р 25—827° С проведен термодинамич. анализ ряда р-ций в системе K_2SiF_6 (тв.) (I)—H₂O (газ.). Показано, что пирогидролиз I становится более вероятным, чем термич. разл. соли, выше 500° С; наиболее вероятными продуктами являются силикат калия, к-тный модуль к-рого уменьшается с ростом т-ры, и KF. Динамич. изотермич. методом в интервале т-р 500—750° С и парц. давл. паров воды 0,03—1,00 атм с привлечением хим., рентгенофазового, ИК-спектроскопич. и ДТА методов анализа установлено, что пирогидролиз I протекает по р-ции I+2,5 H₂O→KF+ +0,5 K₂Si₂O₅+5 HF.

Автореферат

Пирогидролиз

X. 1982, 19, N5.

K_2SiF_6

1982

' 98: 186686e Thermodynamics of the interaction of fluorosilicates of potassium, zinc and lead with sodium soluble glass in acid-resisting compositions. Babushkina, M. I.; Babushkin, V. I. (USSR). Deposited Doc. 1982, VINITI 1668-82, 7 pp. (Russ). Avail. VINITI. Activities in the systems and free energies of 12 possible reactions between $(Na_2O.nSiO_2)_{glass}$ ($n = 1-4$) with $\underline{K_2SiF_6}$, $\underline{ZnSiF_6}$, or $\underline{PbSiF_6}$ and H_2O were detd. at 298-473 K.

D_2H_2

(72) 18



C. A. 1983, 98, N 22.

$K_4 Si_4 Te_{10}$

1982

8 Б432. $K_4 Si_4 Te_{10}$. Первый силикат теллура с алмазоподобными анионами $Si_4 Te_{10}^{4-}$. $K_4 Si_4 Te_{10}$, das erste Tellurosilicat mit Adamantan-analogen $Si_4 Te_{10}^{4-}$ -Anionen. Eisenmann Brigitte, Schäfer Herbert. «Z. anorg. und allg. Chem.», 1982, 491, № 8, 67—72 (нем.; рез. англ.)

Осуществлен синтез (взаимодействием элементов в атмосфере Ag при т-ре 650°), хим. и рентгенографич. (методы Вейсенберга, прецессии и дифрактометра, λ Cu и Mo, МНК, анизотропное приближение, R 0,077 для 1828 отражений) исследования кристаллов $K_4 Si_4 Te_{10}$. Параметры ромбич. решетки: a 21,258, b 12,005, c : 10,608 Å, ρ (изм.) 3,79, ρ (выч.) 3,85, Z 4, ф. гр. $Pn\bar{a}$. Атомы Si находятся в искаженной тетраэдрич. координации из атомов Te ($Si—Te$ 2,431—2,551 Å). Тетраэдры $SiTe_4$ соединяются по 4 общими ребрами в алмазоподобные изолированные анионы $Si_4 Te_{10}^{4-}$, аналогич-

Схема,
параметры
решётки

X. 1983, 19, N8

ные по строению анионам $\text{Ge}_4\text{S}_{10}^{4-}$, $\text{Si}_4\text{S}_{10}^{4-}$ и молекулам P_4S_{16} . Между собой анионы $\text{Si}_4\text{Te}_{12}^{4-}$ соединяются катионами K^+ , находящимися в 2 типах координации окружения: октаэдрич. и неправильного 8-кратного ($\text{K}-\text{Te}$ 3,428—4,211 Å). В $\text{K}_4\text{Si}_4\text{Te}_{16}$ впервые отмечена тетраэдрич. координация атомов Si атомами Te; в других соединениях (Si_2Te_3 , $\text{K}_6\text{Si}_2\text{Te}_6$, $\text{Na}_6\text{Si}_2\text{Te}_6$) имеет место октаэдрич. окружение гантелей Si₂ атомами Te.

С. В. Соболева

Kl - K₂SiF₆

1983

Kl - K₃SiF₇

49-

page gear

99: 11710b Fusibility of the potassium fluoride-potassium chloride-potassium hexafluorosilicate system. Boiko, O. I.; Chernov, R. V. (Inst. Obshch. Neorg. Khim., Kiev, USSR). Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.) 1983, 49(5), 548-51 (Russ). DTA, visual-polythermal, and x-ray phase anal. data were used to construct the phase diagrams of the KCl-K₂SiF₆, KCl-K₃SiF₇, and KCl-KF-K₂SiF₆ systems. Both binary sections are simple eutectic type with eutectics at 655, 660° and ~58, ~79 mol % KCl, resp. Two ternary eutectics occur at 587, 637° and KCl 48.3, 63.3, KF 45.7, 9.7, K₂SiF₆ 6.0, 27.0 mol %, resp.

c.A. 1983, 89, n2

$K_2[SiF_6]$

1983

19 Б960. Термическое разложение $K_2[SiF_6]$ с учетом примесей, введенных при получении образцов, и влияние окружающей атмосферы. Die thermische Zersetzung von $K_2[SiF_6]$ unter Berücksichtigung herstellungsbedingter Verunreinigungen und des Einflusses der Gasatmosphäre. Kolditz L., Wilde W. «Z. Chem.», 1983, 23, № 4, 144 (нем.)

С помощью ГХ, высокот-риой рентгенографии и масс-спектрометрии изучено влияние примесей на термич. разл. K_2SiF_6 (I). Образцы I, полученные из SiO_2 и плавиковой к-ты с последующей нейтрализацией поташом, содержат примеси кислорода и водорода, по-видимому, в виде химически связанных групп OH. При получении из хлоридов в образцах I содержится незначит. кол-во примесей хлорид-иона. Наиболее чистые образцы I получены обработкой их в токе фтора. При нагревании образцов I, содержащих OH-ионы, до 600°, в парах обнаружены следы воды, а в остатке после термич. разл. I — силикат калия. Разл. I идет через промежут. образование K_3SiF_7 с конечным продуктом KF.

термическое
разложение

д. 1983, 19,
N 19

Л. Г. Титов

K_3SiF_7
 $K_2[SiF_6]$

1983

23 Б942. О получении фазы K_3SiF_7 термическим разложением $K_2[SiF_6]$. Zur Bildung der Phase K_3SiF_7 durch thermische Zersetzung von $K_2[SiF_6]$. Kolditz L., Wilde W., Bentrup U. «Z. Chem.», 1983, 23, № 7, 246—247 (нем.)

С помощью ДТА и ТГА изучено термич. / разл. $K_2[SiF_6]$ (I). Показано, что образование K_3SiF_7 (III) не происходит непосредственно при термич. разл. I, а по схеме: 1) I \rightarrow 2KF + SiF₄; 2) 3KF + SiF₄ \rightarrow II; 3) KF + I \rightarrow II.

Л. Г. Титов

термич.

разложение

X. 1983, 19, № 23

1984

|||||||

K_2SiF_6

Крj

» 5 Б3167. Особенности термического разложения кремнефторида калия. Чернов Р. В., Дюбова Л. Д. «7 Всес. симп. по химии неорган. фторидов, Душанбе, 9—11 окт., 1984». М., 1984, 343

Методами дериватографии, термогравиметрии и рентгенографии с использованием хим. анализа изучены термич. св-ва K_2SiF_6 (I) в условиях, необходимых для электролитич. получения кремния. Исследована термич. устойчивость индивидуального I, в расплаве (I—KCl) эвт. и с добавками SiO_2 и CuO . Изучение термич. диссоциации I подтвердило образование более устойчивых соединений K_3SiF_7 , и возможного соединения 2 I·KF, существующего в узкой т-рной области 830—850° С. До-

X. 1985, 19, N5

бавки до 9,3% SiO_2 и до 1,1% CuO практически не влияют на кинетику разложения соли при 700—750° С и замедляют ее при 800° С. Процесс разложения I в жидк. фазе (I — KCl) эвт. замедляется по сравнению с термич. диссоциацией в тв. фазе. Введение добавок CuO (до 1,1%) понижает, а SiO_2 (до 5,1%) повышает скорость разложения кремнефторидных расплавов при 700° С. Установлено, что существенное влияние на термич. стабильность расплава I — KCl оказывает материал тигля.

По резюме

K₂SiP₂

1984

24 Б2024. K₂SiP₂, фосфидополисиликат. K₂SiP₂, ein Phosphidopolysilikat (IV). Eisenmann Brigitte, Somer Mehmet. «Z. Naturforsch.», 1984, B39, № 6, 736—738 (нем.; рез. англ.)

Проведен РСТА (λ Mo, анизотропный МНК, R 0,043 для 399 отражений) кристаллов K₂SiP₂, синтезированных взаимодействием элементов в вакууме 10⁻³ торр при т-ре 800° С. Параметры ромбич. решетки: a 12,926 Å, b 6,867, c 6,107, ρ (выч.) 2,061, Z 4, ф. гр. *Ibam*. Атомы Si в структуре находятся в тетраэдрич. координации из 4 атомов P (Si—P 2,272 Å). Тетраэдры соединяются ребрами в цепи, проходящие в направлении оси c и связанные между собой атомами K. Координац. окружение атомов Si

*параметры
решётки*

X. 1984, 19, N 24

дополнено 4 атомами К до искаженной квадратной антипризмы (К—Si 3,380 Å). Координац. многогранник вокруг атомов К также представлен искаженной квадратной антипризмой, вершины к-рой заселены 2 атомами Si и 6 атомами P (К—P 3,322—3,540 Å). По данным ДТА т. пл. K_2SiP_2 855°С. Цепи $[SiP_2]_{\infty 1}^{2-}$ изостеричны SiS_2 . С. В. Соболева

K_2SiF_6

1984

18 Б2038. Повторное определение структуры калиевого гексафторсиликата, K_2SiF_6 . Redetermination of the structure of potassium hexafluorosilicate, K_2SiF_6 . Loehlin James H. «Acta crystallogr.», 1984, C40, № 3, 570 (англ.)

С целью уточнения ранее известной структуры проведен РСТА (дифрактометр, анизотропный МНК, $R = 0,015$ для 89 отражений) кристаллов K_2SiF_6 . Параметр кубич. решетки: $a = 8,134 \text{ \AA}$, $\rho(\text{изм.}) = 2,71$, $\rho(\text{выч.}) = 2,719$, $Z = 4$, ф. гр. $Fm\bar{3}m$. Уточненное межатомное расстояние $\text{Si}-\text{F} = 1,683 \text{ \AA}$ в октаэдрич. анионах SiF_6^{2-} находится в хорошем соответствии с расстояниями в структурах других гексафторсиликатов (1,643—1,706 \AA). С. В. Соболева

структура

X.1984, 19, N 18

K_2SiF_6

K_3SiF_7

термический
анализ
процесса
разложения

Х. 1984, 19, N 16

1984

) 16 Б3121. Динамический термический анализ процесса разложения K_2SiF_6 . Dynamisch thermische Analyse der Zersetzung von K_2SiF_6 . Menz D., Wilde W., Kolditz L. «J. Fluor. Chem.», 1984, 24, № 3, 345—354 (нем.; рез. англ.)

Процесс термич. разл. K_2SiF_6 (I) при нагревании в интервале 0—1200° С в атмоофере Ar исследован методами ДТА, ТГА (прибор Mettler, скорость нагревания 10°/мин) с одновременным масс-спектрометрич. анализом газ. продуктов. В газ. фазе обнаружены (в скобках — относит. интенсивности) SiF_4^+ (2), SiF_3^+ (100), SiF_2^+ (0,5), SiF^+ (2,5), Si^+ (16) и F^+ (8). Первая потеря массы обнаруживается при 650° С, эндотермич. эффекты установлены при 710, 800 и 850° С. Они вызваны улетучиванием SiF_4 с образованием промежут. соединения K_3SiF_7 , к-рое идентифицировано рентгенографически. Потеря массы при 750—825° С вызвана частичным гидролизом и сопровождается образованием силикатов калия. I может служить модельным в-вом при исследовании процессов разл. и гидролиза др. комплексных соединений методом ДТА.

Л. А. Резницкий

$K_2 SiF_6$

1984

Vieillard Philippe,
Jenkins H. Donald B.

$\Delta_f H^\circ$; C.R. Acad. Sci., Ser. 2
1984, 299(3), 101-3.

($Cu \cdot Li_2 SiF_6(k)$; I)

$K_2[SiF_6]$

1985

2 Б3138. О влиянии газовой фазы на термическое разложение $K_2[SiF_6]$. Zum Einfluß der Gasphase auf die thermische Zersetzung von $K_2[SiF_6]$. Kolditz L., Nitzsche V. «Z. anorg. und allg. Chem.», 1985, 526, № 7, 48—54 (нем.; рез. англ.)

С помощью ГХ, рентгенографии и ИК-спектроскопии изучено влияние H_2O и HF на термич. разл. K_2SiF_6 (I). Образцы I получены р-цией SiO_2 с плавиковой к-той и последующим взаимодействием полученной H_2SiF_6 с K_2CO_3 . Показано, что разл. I при $600^\circ C$ в токе азота происходит с отщеплением SiF_4 (II) и образованием K_3SiF_7 . Установлено, что выше $400^\circ C$ наличие воды в газ. фазе приводит к значит. гидролизу, и на Пв I образуется SiO_2 . Увеличение конц-ии HF в газ. фазе приводит к увеличению конц-ии II, особенно при т-рах ниже $600^\circ C$. Р-ция разл. тормозится образованием на Пв таблеток I защитного слоя из фторосилоксанов.

Л. Г. Титов

термическое
разложение

X, 1986, 19, № 2

K_2SiF_6

1985

20 Б4040. Термодинамическая и кинетическая устойчивость гексафторокомплексов кремния и германия.
Плахотник В. Н., Ярышкина Л. А. «Координац. химия», 1985, 11, № 6, 761—765

Проведено сравнение констант равновесия 1-й ступени гидролиза SiF_6^{2-} и GeF_6^{2-} в интервале т-р от 0 до 50° С с образованием соотв. пентафтораквокомплексов по след. ур-нию: $\mathcal{E}F_6^{2-} + H_3O^+ \rightarrow \mathcal{E}F_5OH_2^+ + HF$, где $\mathcal{E} = Si, Ge$. Рассчитанные значения термодинамич. параметров этого процесса для K_2SiF_6 составляют: $\Delta H_{298}^0 = 22,2$ кДж/моль, $\Delta G_{298}^0 = 4,6$ кДж/моль, $\Delta S_{298}^0 = 57,8$ Дж/(моль·К); для K_2GeF_6 : $\Delta H_{298}^0 = 11,7$ кДж/моль, $\Delta G_{298}^0 = -2,5$ кДж/моль, $\Delta S_{298}^0 = 48,2$ Дж/(моль·К). Т. обр., в ряду двухзарядных октаэдрич. гексафторокомплексов SiF_6^{2-} , TiF_6^{2-} , GeF_6^{2-} наблюдаются снижение термодинамич. и одновременно рост кинетич.

ΔH_{298}^0 , ΔG_{298}^0 ,
 ΔS_{298}^0

(4) Р

Х. 1985, 19, № 20

" K_2GeF_6 (ΔH_{298}^0 , ΔG_{298}^0 , ΔS_{298}^0)
1) SiF_6^{2-} 3) TiF_6^{2-} 4) GeF_6^{2-}

устойчивости. Рассчитанные константы скорости отрыва молекулы воды от пентафтороанионов значительно превышают величины, характеризующие отрыв ионов F^- . В ряду SiF_6^{2-} , TiF_6^{2-} , GeF_6^{2-} происходит уменьшение констант скоростей и рост энергий активации как для отщепления фторид-иона, так и для отщепления молекул воды. Высказано предположение о значит. вкладе электростатич. отталкивания EF_5^- и F^- в переходном состоянии.

Е. М. Согомонян

$(K_2O)_x(SiO_2)_{1-x}$ 1985
Rogez J.,
Mathieu J.-C.
Phys. and Chem. Liquids
14; 1985, 14, NY, 259-271.

(e.g. $(Na_2O)_x(SiO_2)_{1-x}$; ?)

K₂SiF₆

1985

24 Б3180. Некоторые аспекты реальной структуры и термическое разложение K_2SiF_6 . Some aspects of real structure and thermal decomposition of K_2SiF_6 . Stodolski R., Kolditz L. «J. Fluor. Chem.», 1985, 29, № 1—2, 73 (англ.)

С помощью хим. анализа, ИК- и КР-спектроскопии изучено термич. разл. и структура K_2SiF_6 (I). Установлено, что реальная структура I отличается от структуры др. гексафторосиликатов тем, что в ней образуются силоксановые мостики, подобные тем, к-рые образуются во фторосилоксанах или оксафторосиликатах при замене фтора на кислород. I, осажденный в щел. р-ре, содержит др. тип силоксановых мостиков и силанольных групп (по-видимому, за счет замещения фторид-иона на гидроксильную группу), в то время как Na_2SiF_6 в щел. р-ре гидролизуется с образованием SiO_2 (II) и NaF. Термич. разл. I при 673—773 К на воздухе приводит к гидролитич. р-циям, к-рые идут в две стадии: 1) образование II и K_3SiF_7 (III) за счет хемосорбции воды на I; 2) гидролиз III с образованием силикатов калия. Термич. диссоциация I при 793 К происходит по р-ции $3I \rightarrow 2III + SiF_4$.

Л. Г. Титов

*термический
разложениe*

*X. 1985, 19,
N 24*

K_2SiF_6

1985

21 Б3178. Термическое разложение K_2SiF_6 : влияние поверхности и парциального давления водяных паров. Thermische Zersetzung von K_2SiF_6 : Einfluß von Oberfläche und Wasserdampfpartialdruck. Stodolski R., Kolditz L. «Z. Chem.», 1985, 25, № 5, 190—191 (нем.)

С помощью рентгенографии и ИК-спектроскопии (*in situ*) изучено влияние Пв и парц. давл. вод. паров на термич. разл. K_2SiF_6 (I). При небольшой Пв (таблетки I) и ничтожно малом парц. давл. вод. паров (инертный газ, вакуум) при 400—500° С доказано образование рентгеноаморф. SiO_2 (II), содержащей фтор, к-рая при длительной выдержке при 550° С кристаллизуется в кристобалит. Установлено также образование K_3SiF_7 (III). При разл. на воздухе образуется неизвестн. кол-во KOH. На воздухе при разл. I с большой Пв (порошок) сначала образуется III и II, а затем

термический
разложившийся

X. 1985, 19, № 21

рентгеноаморф. силикат калия со структурой аниона, похожей на структуру $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$, к-рый затем превращается в слоистый силикат, содержащий КF. При т-ре $\sim 570^\circ\text{C}$ образуется газ. и тв. (рентгеноаморф.) фторосилоксаны. Обсужден механизм и возможные р-ции при термич. разл. I.

Л. Г. Титов

$2K_2CO_3 \cdot K_2SiF_6$

1988

(II_m)

110: 83033b Fusibility and specific electrical conductivity of the melts in the system of potassium carbonate-potassium hexafluorosilicate. Trifonov, K. I.; Postnov, I. I.; Desyatnik, V. N.; Bersteneva, L. V.; Fomina, I. P. (Ural. Politekh. Inst., Sverdlovsk, USSR). *Rasplavy* 1988, 2(4), 123-5 (Russ.). Phase relations were detd. by DTA and x-ray phase anal. The sp. elec. conductivities were measured by a capillary method at 50 kHz. The compd. $2K_2CO_3 \cdot K_2SiF_6$ congruently m. 1103 ± 2 K. Eutectics occur at K_2SiF_6 10 and 49 mol% and 935 ± 2 and 1007 ± 2 K, resp. The sp. elec. cond. isotherms reflect the invariant transitions.

C.A. 1989, 110, N10

K SiF₅

1988

Взаимодействие гептафторсиликата калия в бинарных и тройных смесях с галогенидами и гексафторалюминатом калия / Трифонов К. И., Дыхановский А. В., Кузьменко Н. А., Десятник В. Н.

// Журн. неорган. химии. — 1988. — Т. 33, вып. 2. — С. 551—553.

ISSN 0044—457x

— — 1. Калий, хлорид — Исследование в системах. 2. Калий, кремнийфториды — Исследование в системах. 3. Калий, алюмофториды — Исследование в системах.

№ 42880

18 № 1300 [88-5919ж]
НПО ВКП 29.04.88

УДК 546.32'131'161+546

ЕКЛ 17.8

$K_3Si_6N_5(NH)_6$

1990

24 В9. Получение и кристаллическая структура имидонитридсиликата калия, $K_3Si_6N_5(NH)_6$. Darstellung und Kristallstruktur eines Kaliumimidonitridosilicats, $K_3Si_6N_5(NH)_6$ / Peters D., Paulus E. F., Jacobs H. // Z. anorg. und allg. Chem.— 1990.— 584, № 5.— С. 129—137.— Нем.; рез. англ.

Взаимодействием в автоклаве калия и кремния, взятых в ат. отношении 1 : 1, в аммиаке при сверхкрит. условиях (давл. NH_3 — 6 кбар, т-ра — 500° С, продолжительность р-ции — 3 суток) получены кристаллы $K_3Si_6N_5(NH)_6$ (I). Выполнен РСТА I [517 отражений с $F_0^2 \geq 3\sigma (F_0^2)$, $R = 0,019$, $R_w = 0,017$]. Кристаллы I кубич., $a = 10,789(4)$ Å, ρ (эксперим.) 2,358 г/см³, $Z = 4$, пр. гр. $P4_332$. Условия синтеза и особенности строения I обсуждены в сопоставлении с подобными данными для Si_3N_4 и $Si_2N_2(NH)$. По резюме

Х. 1990, № 24